

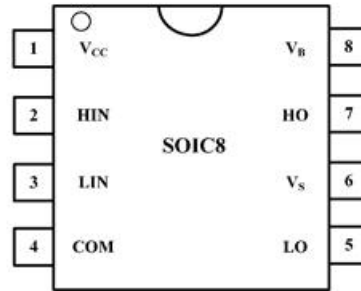
概述

PN7101 是一款基于 P 衬底、P 外延的高压、高速功率 MOSFET 和 IGBT 高低侧驱动芯片。其浮地通道能工作在 600V 的高压下，可用于驱动 2 个 N 型功率 MOSFET 或 IGBT 结构。该芯片逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平。输出具有大电流脉冲能力。传输延时具有匹配性，以简化在高频下的应用。

特征

- 高压范围达+600 V
- 3.3 V 逻辑兼容
- 抗 dV/dt 能力±50 V/nsec
- 自举工作的浮地通道
- 栅驱动电压范围 10V~20V
- 低侧欠压保护 (UVLO) 功能
- 输出拉灌电流能力 300 mA / 600mA
- 独立的逻辑输出以适应所有的拓扑结构
- 抗-5V 瞬态负 Vs 能力
- 高低侧通道均延时匹配

封装/订购信息



应用

- 中小型功率电机驱动
功率 MOSFET 或 IGBT 驱动

型号	订购代码	封装
PN7101	PN7101SEC-R1	SOIC8

典型应用

